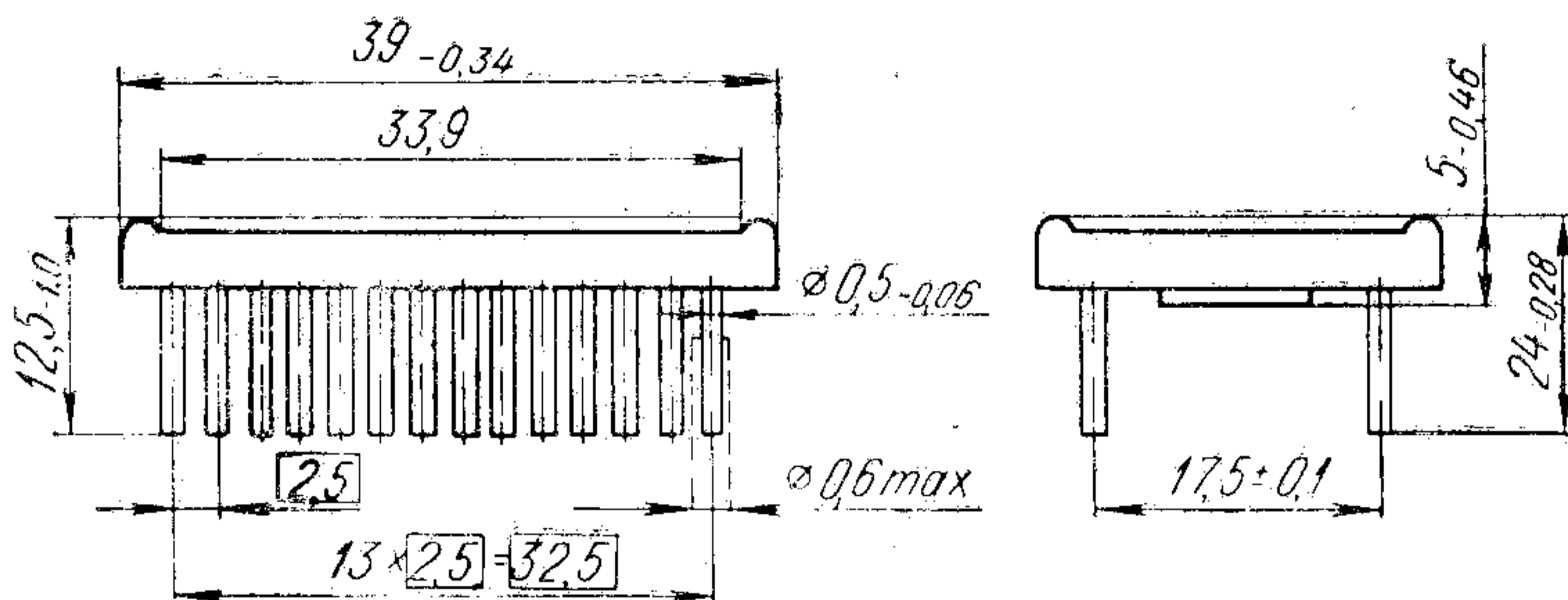


# МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 301

## Общие данные

### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса не более 10 г

### ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

#### Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц

для микросхем 301НР1—301НР6 . . . . .	от 1 до 3000
» » 301НР7—301НР12 . . . . .	от 1 до 5000

амплитуда ускорения, м·с<sup>-2</sup> (g)

для микросхем 301НР1—301НР6 . . . . .	150 (15)
» » 301НР7—301НР12 . . . . .	400 (40)

#### Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, м·с<sup>-2</sup> (g)

для микросхем 301НР1—301НР6 . . . . .	5000 (500)
» » 301НР7—301НР12 . . . . .	15 000 (1500)

длительность действия ударного ускорения, мс

от 0,1 до 2,0

#### Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение, м·с<sup>-2</sup> (g)

для микросхем 301НР1—301НР6 . . . . .	750 (75)
» » 301НР7—301НР12 . . . . .	1500 (150)

длительность действия ударного ускорения, мс

от 1 до 5

Линейное ускорение, м·с<sup>-2</sup> (g) . . . . .

1500 (150)

#### Повышенная температура среды, °С:

для микросхем 301НР1—301НР6 . . . . .	85
» » 301НР7—301НР12 . . . . .	100

Пониженная температура среды, °С . . . . .

минус 60

#### Изменения температуры среды, °С:

для микросхем 301НР1—301НР6 . . . . .	от минус 60 до +85
» » 301НР7—301НР12 . . . . .	от минус 60 до +100

# МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 301

## Общие данные

Атмосферное пониженное давление, мм рт. ст. (Па):	
для микросхем 301НР1—301НР6 . . . . .	5 (665)
»          »      301НР7—301НР12 . . . . .	$10^{-6}$
Атмосферное повышенное давление, атм . . . . .	3
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

## НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка <sup>О</sup> , ч . . . . .	25 000
Срок сохраняемости <sup>О</sup> , лет . . . . .	25

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

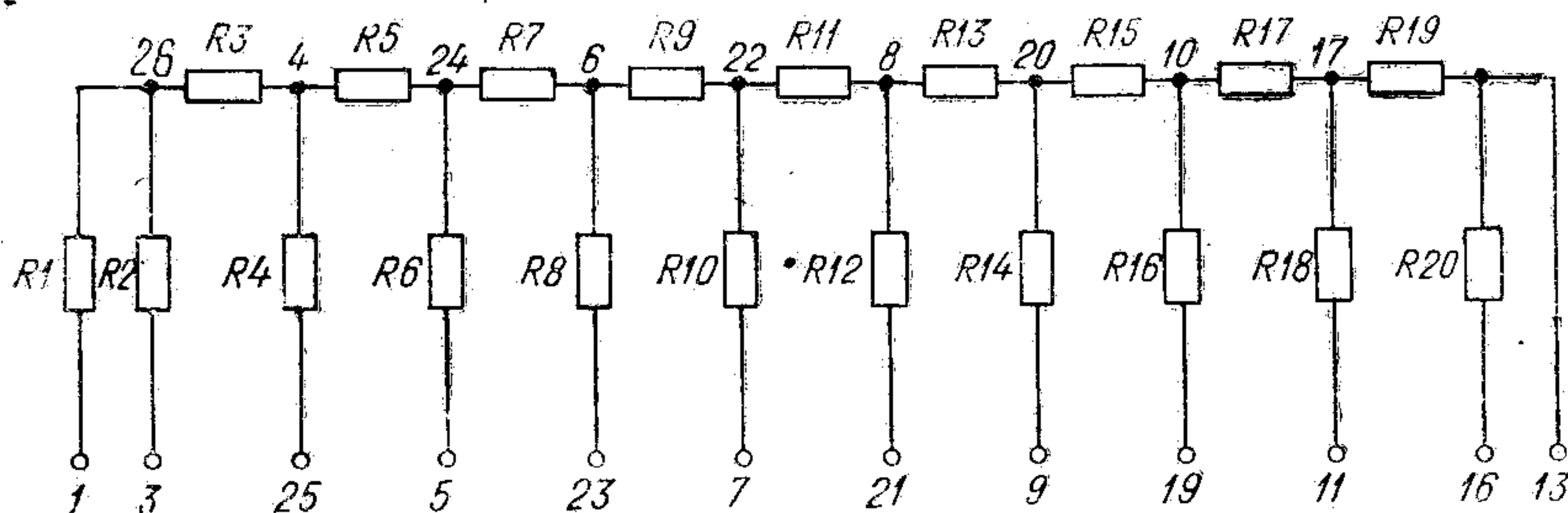
Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

Допускается кратковременная двухкратная перегрузка по напряжению на входах с сохранением характеристик во время и после снятия перегрузки. Длительность воздействия перегрузки для микросхем 301НР1—301НР6 — 2 мин, для микросхем 301НР7—301НР12 — 5 мин, количество перегрузок — не более 5 в течение 1 ч, интервал между перегрузками — не менее 8—10 мин.

Выводы микросхем формовке не подлежат. В технически обоснованных случаях допускается удалять нерабочие выводы микросхем и излишки рабочих выводов после пайки любым способом, исключая нарушение запрессовки вывода в основании корпуса и не приводящим к ухудшению электрических параметров микросхем.

<sup>О</sup> В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



Позици- онное обозна- чение	Точки изме- рения	Расчетный номинал, Ом, для типов микросхем					
		301HP1A	301HP1B	301HP1B	301HP1Г	301HP1Д	301HP1E
R1	1—26	2R	2R	2R	2R	2R	2R
R2	3—26	2R	2R—10	2R—20	2R—30	2R—40	2R—50
R3	26—4	R	R	R	R	R	R
R4	25—4	2R	2R—10	2R—20	2R—30	2R—40	2R—50
R5	4—24	R	R	R	R	R	R
R6	5—24	2R	2R—10	2R—20	2R—30	2R—40	2R—50
R7	24—6	R	R	R	R	R	R
R8	23—6	2R	2R—10	2R—20	2R—30	2R—40	2R—50
R9	6—22	R	R	R	R	R	R
R10	7—22	2R	2R—10	2R—20	2R—30	2R—40	2R—50
R11	22—8	R	R	R	R	R	R
R12	21—8	2R	2R—10	2R—20	2R—30	2R—40	2R—50
R13	8—20	R	R	R	R	R	R
R14	9—20	2R	2R—10	2R—20	2R—30	2R—40	2R—50
R15	20—10	R	R	R	R	R	R
R16	19—10	2R	2R—10	2R—20	2R—30	2R—40	2R—50
R17	10—17	R	R	R	R	R	R
R18	11—17	2R	2R—10	2R—20	2R—30	2R—40	2R—50
R19	17—13	R	R	R	R	R	R
R20	16—13	2R	2R—10	2R—20	2R—30	2R—40	2R—50

Продолжение

Позици- онное обозна- чение	Точки изме- рения	Расчетный номинал, Ом, для типов микросхем				
		301НР1Ж	301НР1И	301НР1К	301НР1Л	301НР1М
R1	1—26	2R	2R	2R	2R	2R
R2	3—26	2R—60	2R—70	2R—80	2R—90	2R—100
R3	26—4	R	R	R	R	R
R4	25—4	2R—60	2R—70	2R—80	2R—90	2R—100
R5	4—24	R	R	R	R	R
R6	5—24	2R—60	2R—70	2R—80	2R—90	2R—100
R7	24—6	R	R	R	R	R
R8	23—6	2R—60	2R—70	2R—80	2R—90	2R—100
R9	6—22	R	R	R	R	R
R10	7—22	2R—60	2R—70	2R—80	2R—90	2R—100
R11	22—8	R	R	R	R	R
R12	21—8	2R—60	2R—70	2R—80	2R—90	2R—100
R13	8—20	R	R	R	R	R
R14	9—20	2R—60	2R—70	2R—80	2R—90	2R—100
R15	20—10	R	R	R	R	R
R16	19—10	2R—60	2R—70	2R—80	2R—90	2R—100
R17	10—17	R	R	R	R	R
R18	11—17	2R—60	2R—70	2R—80	2R—90	2R—100
R19	17—13	R	R	R	R	R
R20	16—13	2R—60	2R—70	2R—80	2R—90	2R—100

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре 25°C)

Максимальное напряжение на выводах 3, 5, 7, 9, 11,  
16, 19, 21, 23, 25 относительно вывода 1, В, не более

12,6

Сопротивление резисторов, кОм:

2R . . . . .

от 9,212 до 10,788

R . . . . .

от 4,606 до 5,394

Относительная погрешность коэффициентов деле-

ния, % . . . . .

±0,0135

Сопротивление изоляции (испытательное напряжение 100 В прикладывается между экраном и закороченными выводами), МОм . . . . .	100
Время установления переходных процессов, мкс . .	0,5

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальная рассеиваемая мощность, мВт . . . .	50
---	----